



## SOD-523 Schottky Barrier Diode 肖特基势垒二极管

### Internal Configuration & Device Marking 内部结构与产品打标

Type 型号	RB521S-40
Pin 管脚	
Mark 打标	

### Absolute Maximum Ratings 最大额定值

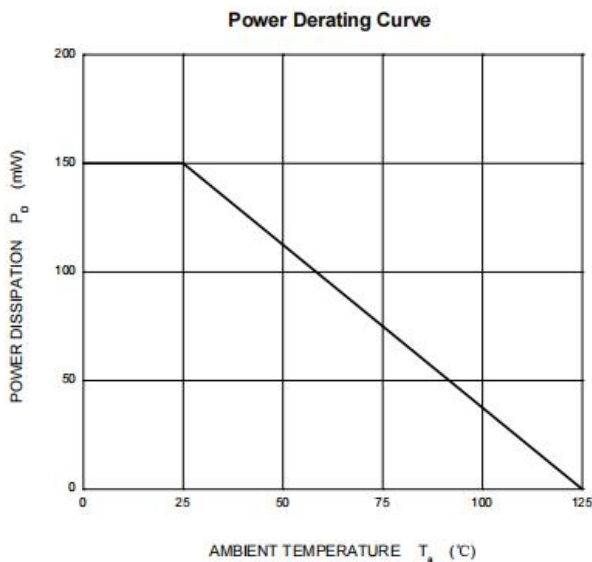
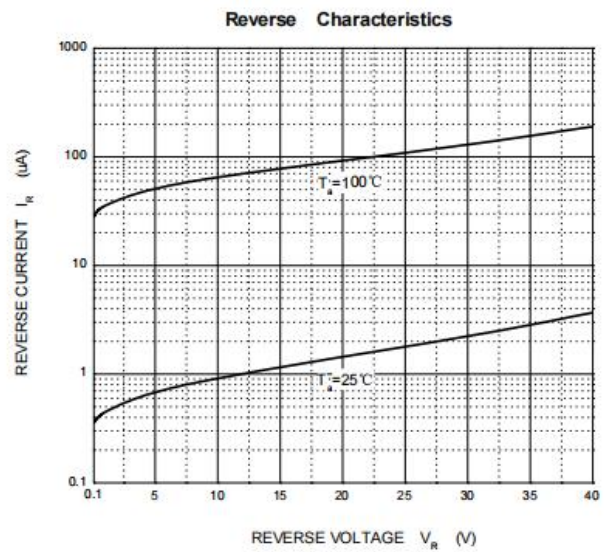
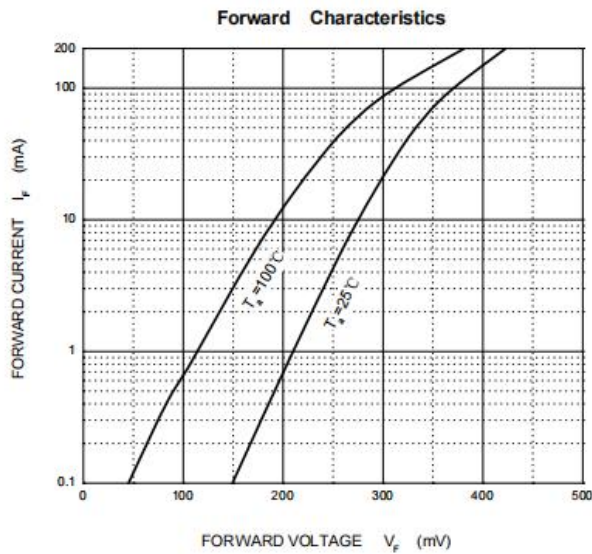
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Peak Reverse Voltage 反向峰值电压	$V_{RM}$	45	V
Repetitive Reverse Voltage 重复反向电压	$V_{RRM}$	40	V
Reverse Work Voltage 反向工作电压	$V_{RWM}$	40	V
RMS Reverse Voltage 反向电压均方根值	$V_R(RMS)$	28	V
Forward Work Current 正向工作电流	$I_O$	200	mA
Peak Forward Surge Current 正向峰值浪涌电流	$I_{FSM}$	1000	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ C)$	150	mW
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	668	$^\circ C/W$
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	$T_J, T_{stg}$	-55to+125 $^\circ C$	

### Electrical Characteristics 电特性

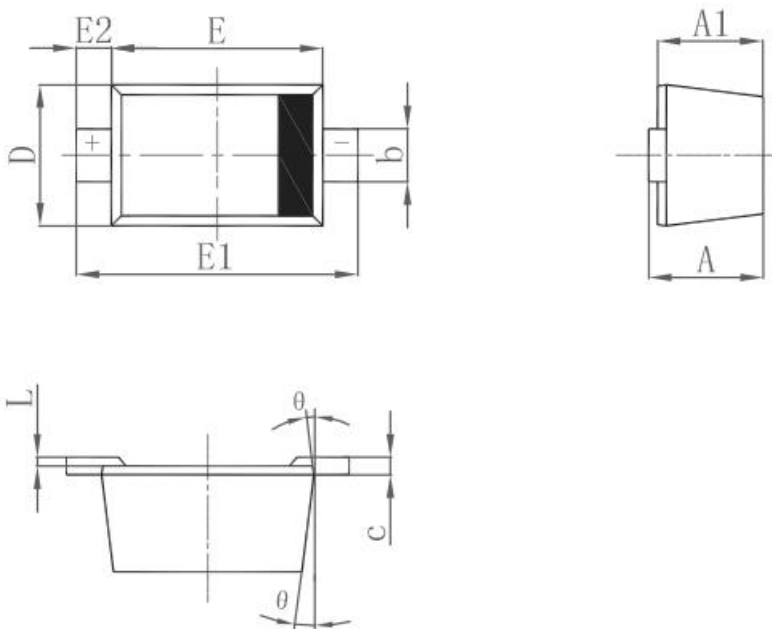
( $T_A=25^\circ C$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为  $25^\circ C$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压( $I_R=100\mu A$ )	$V_{(BR)}$	40	—	V
Reverse Leakage Current( $V_R=10V$ ) 反向漏电流( $V_R=40V$ )	$I_R$	—	20 90	$\mu A$
Forward Voltage( $I_F=10mA$ ) 正向电压( $I_F=100mA$ ) ( $I_F=200mA$ )	$V_F$	0.16 0.31 0.41	0.3 0.45 0.54	V

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.510	0.770	0.020	0.031
A1	0.500	0.700	0.020	0.028
b	0.250	0.350	0.010	0.014
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	0.750	0.850	0.030	0.033
E	1.100	1.300	0.043	0.051
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
E2	0.200 REF		0.008 REF	
L	0.010	0.070	0.001	0.003
θ	7° REF		7° REF	